



LOW POWER NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/391

Qualified Levels:
JAN, JANTX,
JANTXV, and JANS

DESCRIPTION

This 2N3019 NPN leaded silicon transistor device is military qualified for high-reliability applications. Microsemi also offers numerous other transistor products to meet higher and lower power ratings with various switching speed requirements in both through-hole and surface-mount packages.

Important: For the latest information, visit our website <http://www.microsemi.com>.

FEATURES

- JEDEC registered 2N3019 number.
- JAN, JANTX, JANTXV and JANS qualifications are available per MIL-PRF-19500/391.
- Rad hard levels are also available per MIL-PRF-19500/391.
(For RHA datasheet see [JANSJ2N3019](#).)
- RoHS compliant by design.

APPLICATIONS / BENEFITS

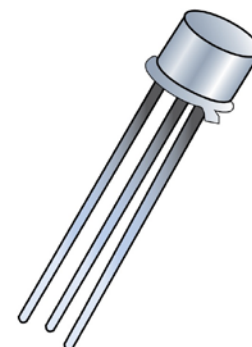
- Long leaded TO-5 package.
- Lightweight.
- Low power.
- Military and other high-reliability applications.

MAXIMUM RATINGS @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameters/Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Junction and Storage Temperature	T_J and T_{STG}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	195	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	30	$^\circ\text{C/W}$
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	140	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7.0	V
Collector Current	I_C	1.0	A
Total Power Dissipation:			
@ $T_A = +25^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾	P_D	0.8	W
@ $T_C = +25^\circ\text{C}$ ⁽²⁾		5.0	

Notes:

1. Derate linearly 4.6 mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_A \geq +25^\circ\text{C}$.
2. Derate linearly 28.6 mW/ $^\circ\text{C}$ for $T_C \geq +25^\circ\text{C}$.



TO-5 Package

Also available in:

TO-39 (TO-205AD)
(short-leaded)
 [2N3019S](#)

TO-46 (TO-206AB)
(leaded)
 [2N3057A](#)

TO-18 (TO-206AA)
(leaded)
 [2N3700](#)

UB package
(leaded)
 [2N3700UB](#)

MSC – Lawrence

6 Lake Street,
Lawrence, MA 01841
Tel: 1-800-446-1158 or
(978) 620-2600
Fax: (978) 689-0803

MSC – Ireland

Gort Road Business Park,
Ennis, Co. Clare, Ireland
Tel: +353 (0) 65 6840044
Fax: +353 (0) 65 6822298

Website:

www.microsemi.com

MECHANICAL and PACKAGING

- CASE: Hermetically sealed, kovar base, nickel cap.
- TERMINALS: Gold plate, solder dip (Sn63/Pb37) available upon request. NOTE: Solder dip will eliminate RoHS compliance.
- MARKING: Part number, date code, manufacturer's ID and serial number.
- POLARITY: NPN.
- WEIGHT: Approximately 1.064 grams.
- See [Package Dimensions](#) on last page.

PART NOMENCLATURE**JAN 2N3019****Reliability Level**

JAN = JAN level
JANTX = JANTX level
JANTXV = JANTXV level
JANS = JANS level
Blank = Commercial

JEDEC type number

(see [Electrical Characteristics](#)
table)

SYMBOLS & DEFINITIONS

Symbol	Definition
f	Frequency
I _B	Base current (dc)
I _E	Emitter current (dc)
T _A	Ambient temperature
T _C	Case temperature
V _{CB}	Collector to base voltage (dc)
V _{CE}	Collector to emitter voltage (dc)
V _{EB}	Emitter to base voltage (dc)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ $T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted

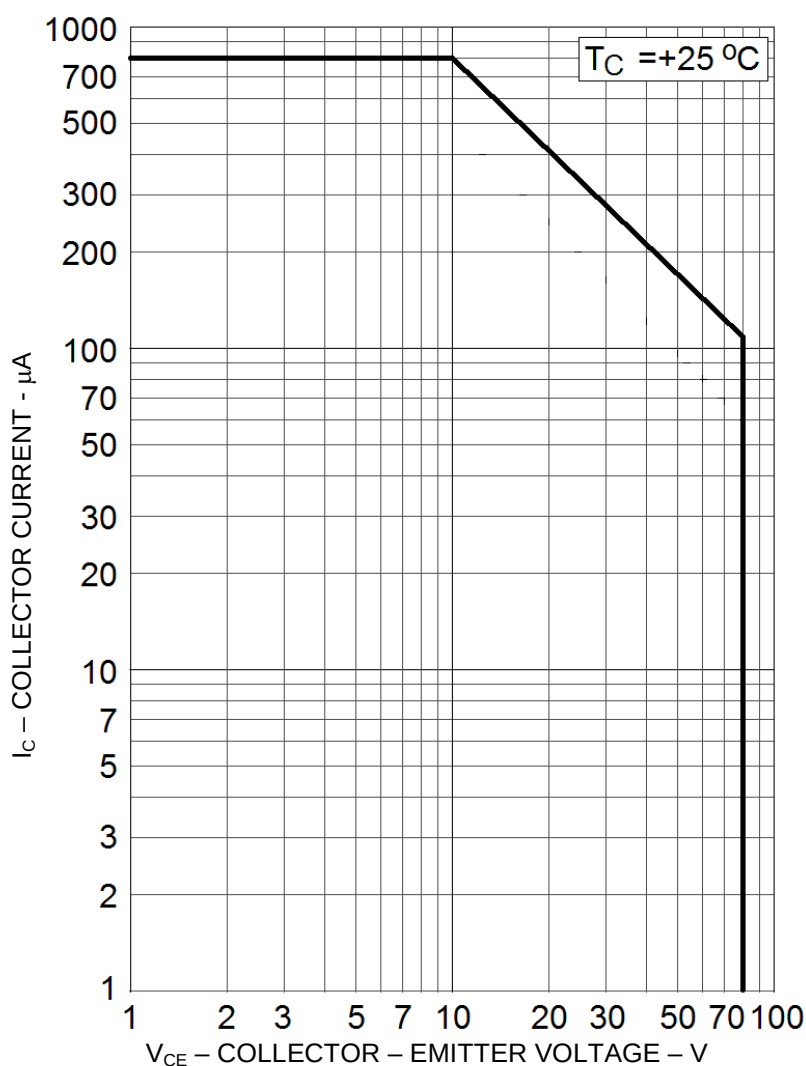
Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 30\text{ mA}$	$V_{(BR)CEO}$	80		V
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 140\text{ V}$	I_{CBO}		10	μA
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 7\text{ V}$	I_{EBO1}		10	μA
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 90\text{ V}$	I_{CES}		10	ηA
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0\text{ V}$	I_{EBO2}		10	ηA
ON CHARACTERISTICS				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 150\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 0.1\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 500\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 1.0\text{ A}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$	h_{FE}	100 50 90 50 15	300 300 300	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150\text{ mA}$, $I_B = 15\text{ mA}$ $I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$	$V_{CE(sat)}$		0.2 0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150\text{ mA}$, $I_B = 15\text{ mA}$	$V_{BE(sat)}$		1.1	V

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0\text{ mA}$, $V_{CE} = 5.0\text{ V}$, $f = 1.0\text{ kHz}$	h_{fe}	80	400	
Magnitude of Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 50\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$, $f = 20\text{ MHz}$	$ h_{fe} $	5.0	20	
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = 0$, $100\text{ kHz} \leq f \leq 1.0\text{ MHz}$	C_{obo}		12	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $I_C = 0$, $100\text{ kHz} \leq f \leq 1.0\text{ MHz}$	C_{ibo}		60	pF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ $T_A = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted (continued)
SAFE OPERATION AREA (See SOA graph below and [MIL-STD-750, method 3053](#))

DC Tests
 $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 cycle, $t = 10\text{ ms}$
Test 1 $V_{CE} = 10\text{ V}$
 $I_C = 500\text{ mA}$
Test 2 $V_{CE} = 40\text{ V}$
 $I_C = 125\text{ mA}$
Test 3 $V_{CE} = 80\text{ V}$
 $I_C = 60\text{ mA}$

(1) Pulse Test: Pulse Width = $300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2.0\%$.

Maximum Safe Operating Area

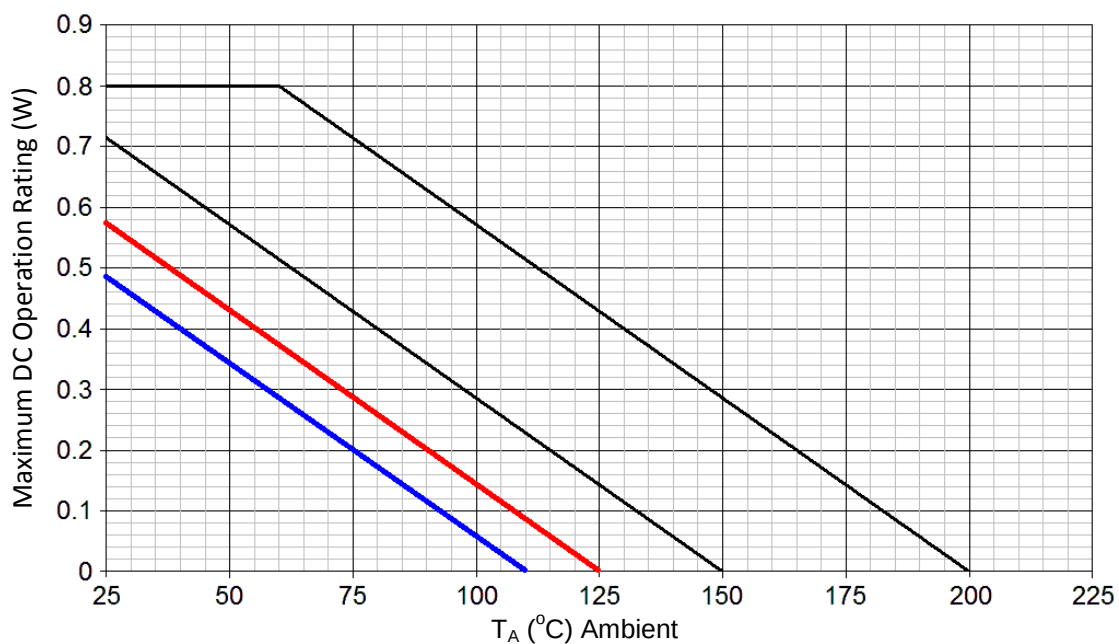
GRAPHS


FIGURE 1
Temperature – Power Derating ($R_{\Theta JA}$)

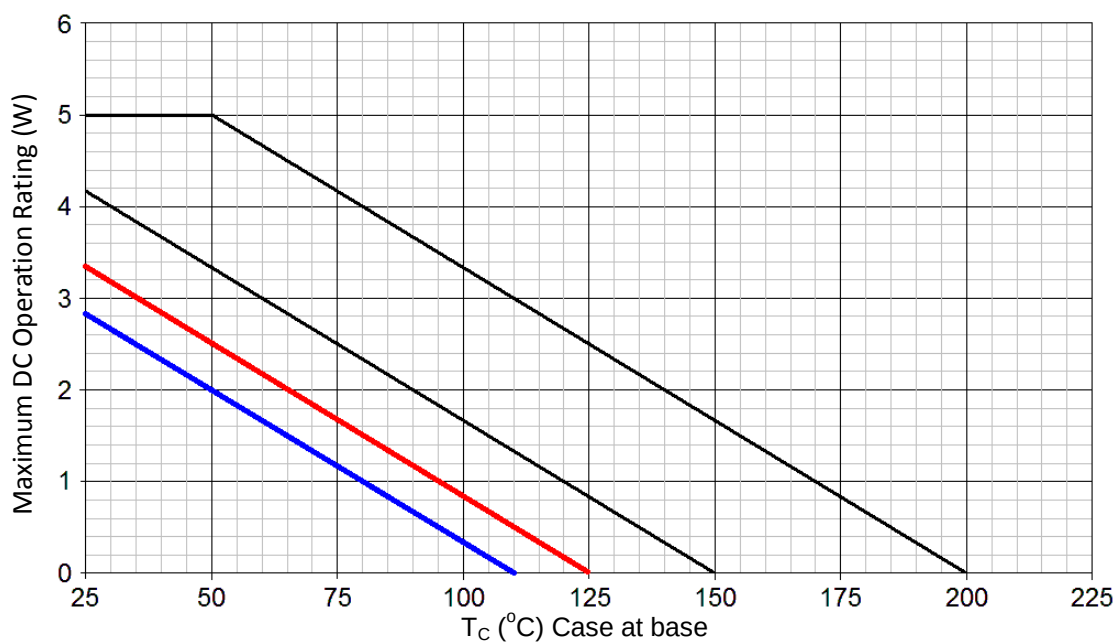
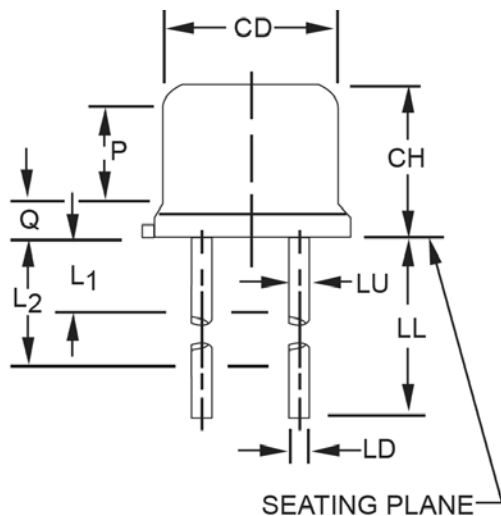
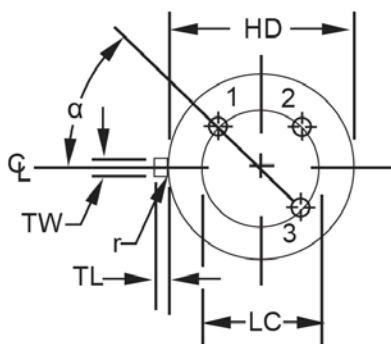


FIGURE 2
Temperature – Power Derating ($R_{\Theta JC}$)

PACKAGE DIMENSIONS


Symbol	Dimensions				Notes
	Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD	.305	.335	7.75	8.51	
CH	.240	.260	6.10	6.60	
HD	.335	.370	8.51	9.40	
LC	.200 TP		5.08 TP		6
LD	.016	.021	0.41	0.53	7, 8
LL	1.500	1.750	38.10	44.45	7, 8
LU	.016	.019	0.41	0.48	7, 8
L ₁		.050		1.27	7, 8
L ₂	.250		6.35		7, 8
Q		.050		1.27	5
TL	.029	.045	0.74	1.14	4
TW	.028	.034	0.71	0.86	3
r		.010		0.25	10
α	45° TP		45° TP		6
P	.100	-	2.54	-	


NOTES:

1. Dimensions are in inches.
2. Millimeters are given for general information only.
3. Beyond r (radius) maximum, TW shall be held for a minimum length of .011 (0.28 mm).
4. Dimension TL measured from maximum HD.
5. Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.
6. Leads at gauge plane .054 +.001 -.000 inch (1.37 +0.03 -0.00 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18 mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC. This device may be measured by direct methods.
7. Dimension LU applies between L₁ and L₂. Dimension LD applies between L₂ and minimum. Diameter is uncontrolled in L₁ and beyond LL minimum.
8. All three leads.
9. The collector shall be internally connected to the case.
10. Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.
11. In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to Φx symbology.
12. Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А